



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D218017 S

(45)公告日：中華民國 111 (2022) 年 04 月 01 日

(21)申請案號：110303748

(22)申請日：中華民國 109 (2020) 年 11 月 19 日

(51)LOC.(13)Cl.：13-99

(30)優先權：2020/05/29 日本

2020-010739

(71)申請人：日商東京威力科創股份有限公司 (日本) TOKYO ELECTRON LIMITED (JP)
日本(72)設計人：永田朋幸 NAGATA, TOMOYUKI (JP)；池內俊之 IKEUCHI, TOSHIYUKI (JP)；
木鎌英司 KIKAMA, EIJI (JP)

(74)代理人：何愛文；王仁君

(56)參考文獻：

TW D112939

TW D133944

TW D133945

TW D174924

TW D175118

TW D182751

JP D156352

US D800080

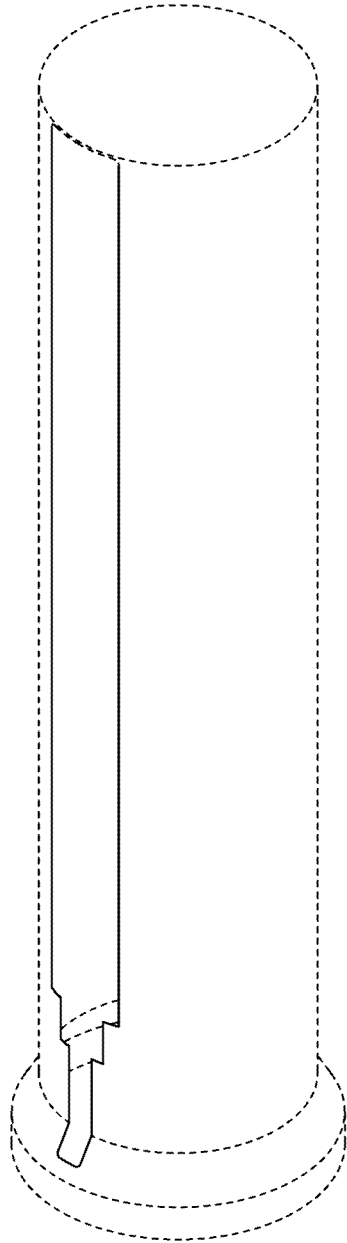
審查人員：徐銘鋒

圖式數：10 共 11 頁

(54)名稱

半導體製造裝置用反應管(四)

代表圖：



【立體圖】



D218017

【設計說明書】

【中文設計名稱】半導體製造裝置用反應管(四)

【物品用途】

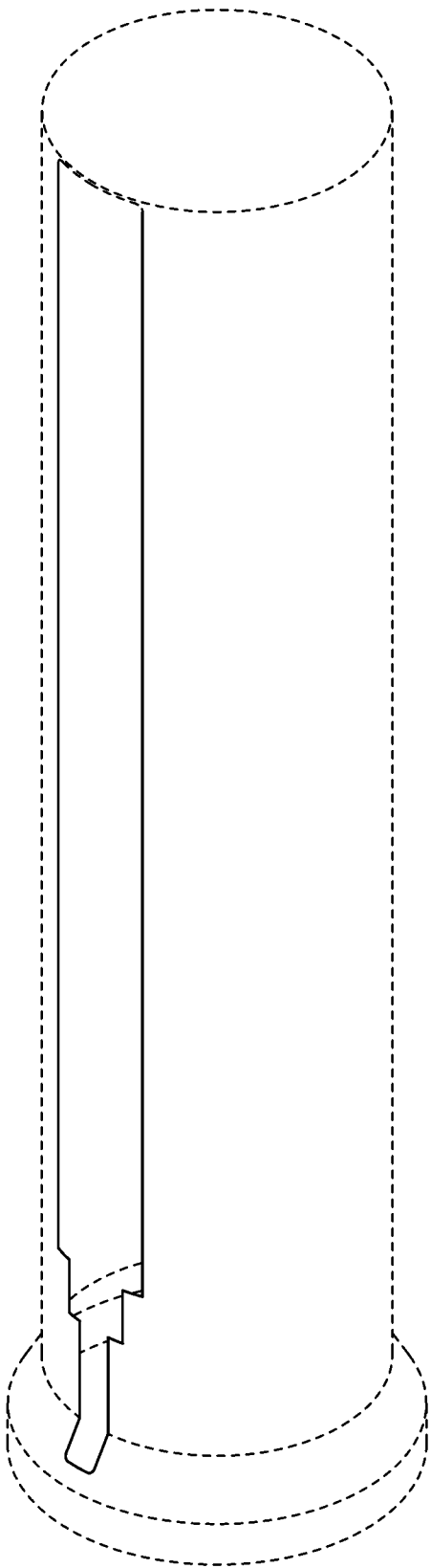
本物品係在半導體製造之成膜過程中，如顯示使用狀態之參考剖面圖所示般地設置於成膜裝置內來讓製品晶圓與氣體反應之管體。具體來說，雖是在層積有製品晶圓之狀態下，來讓氣體流入本物品內而於製品晶圓的表面進行成膜，但此時，必須使本物品內之上下部分的氣體濃度為均勻。欲申請部分設計專利之部分為用以將流入後的氣體排氣之氣體的排出口，係具有能夠使本物品內部整體的氣體濃度為均勻之功能。

【設計說明】

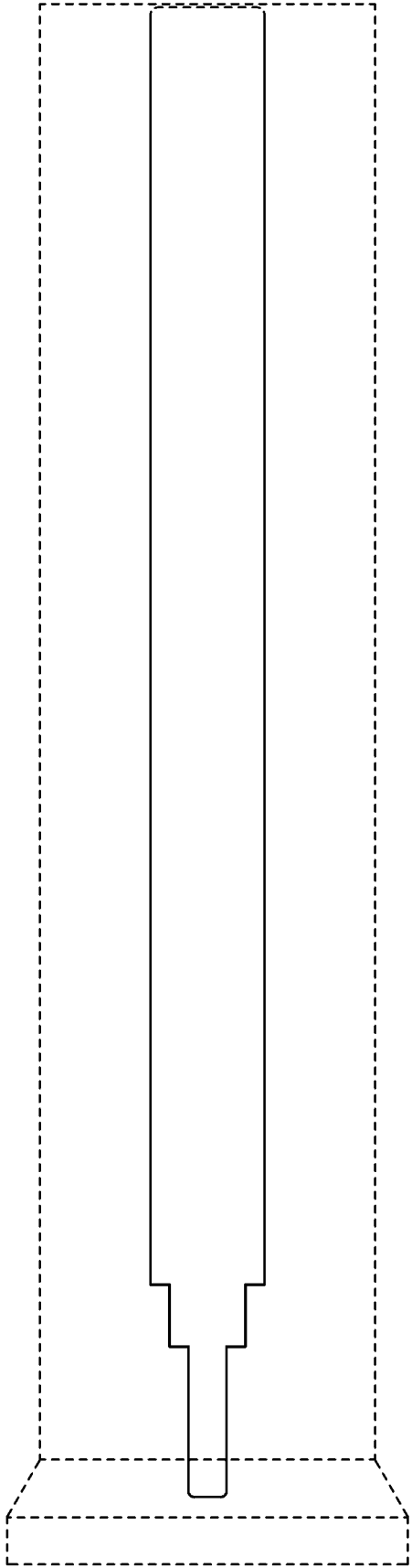
【0001】實線所表示之部分為欲申請部分設計專利之部分，包含「A-A線剖面圖」、「上半部之A-A線部分放大剖面圖」及「下半部之A-A線部分放大剖面圖」，係特定出欲申請部分設計專利之部分。虛線所表示之部分為申請部分設計專利所不欲主張之部分。

【0002】由於左側視圖係與右側視圖對稱，故予以省略。

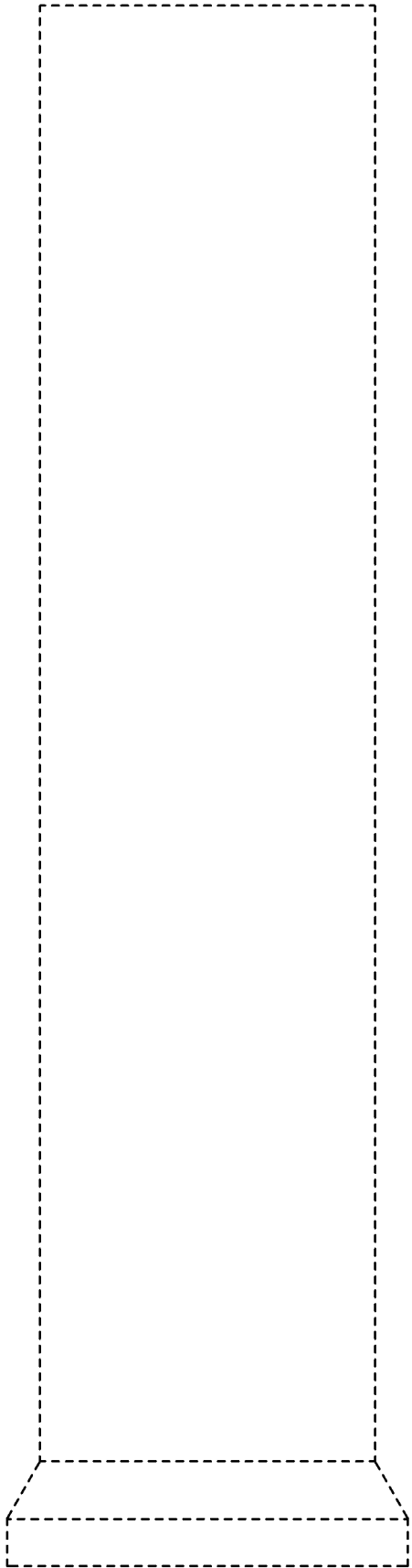
【設計圖式】
(指定代表圖)



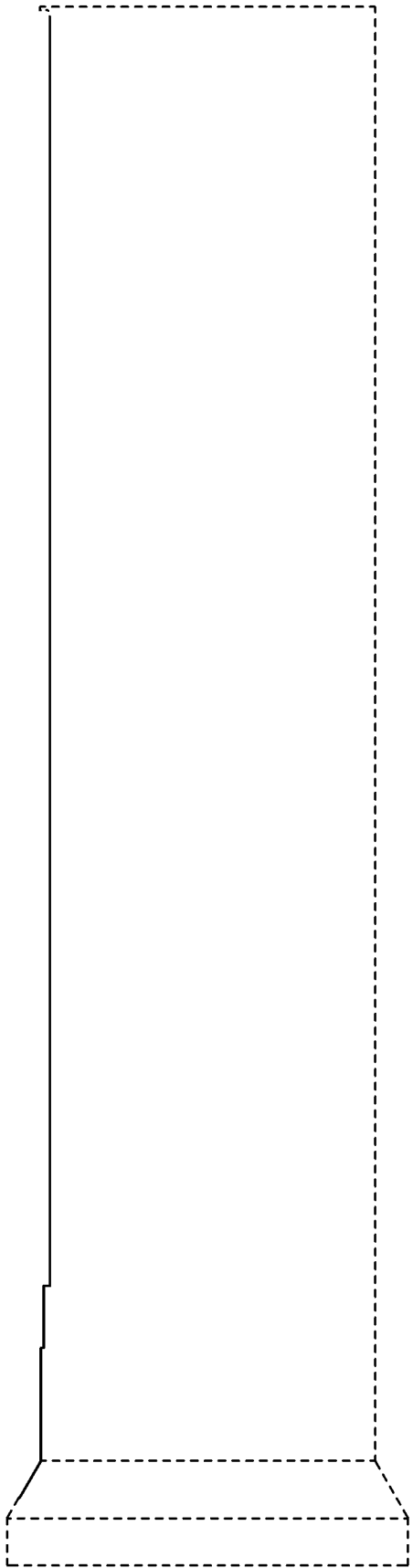
【立體圖】



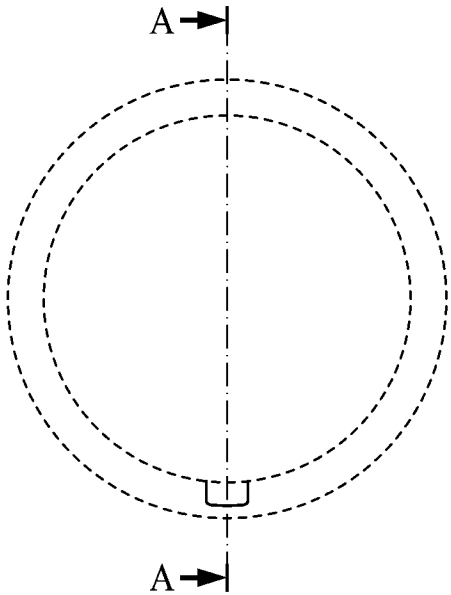
【前視圖】



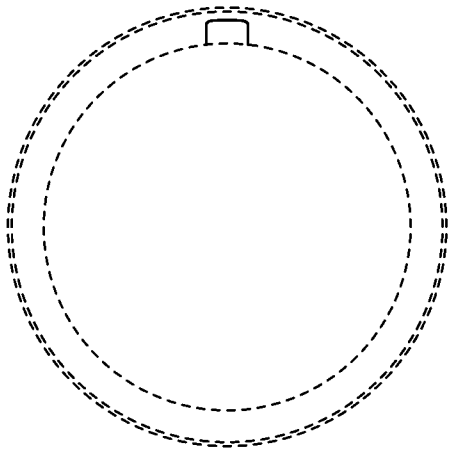
【後視圖】



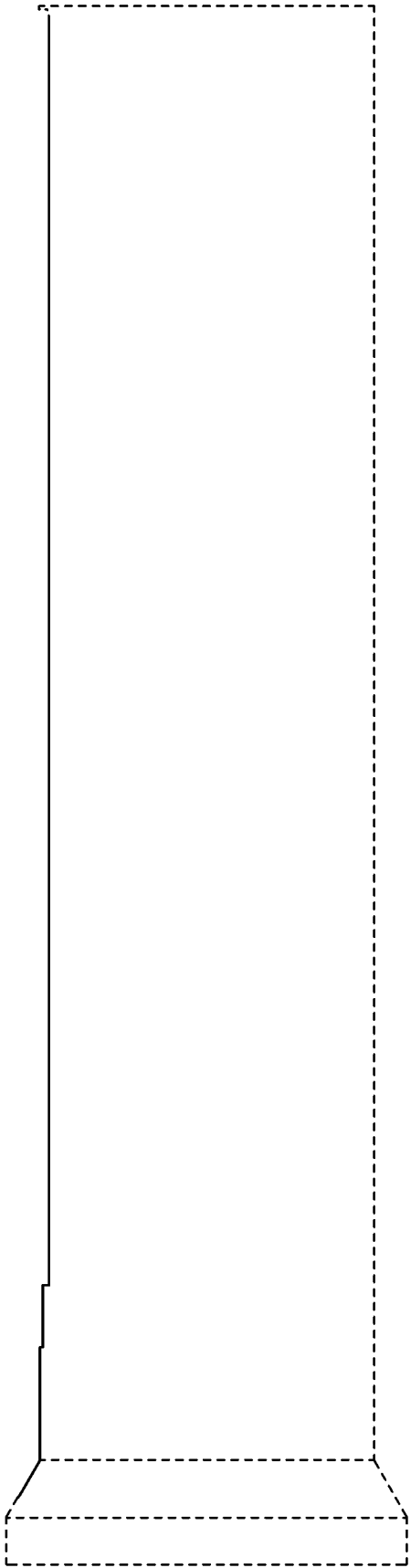
【右側視圖】



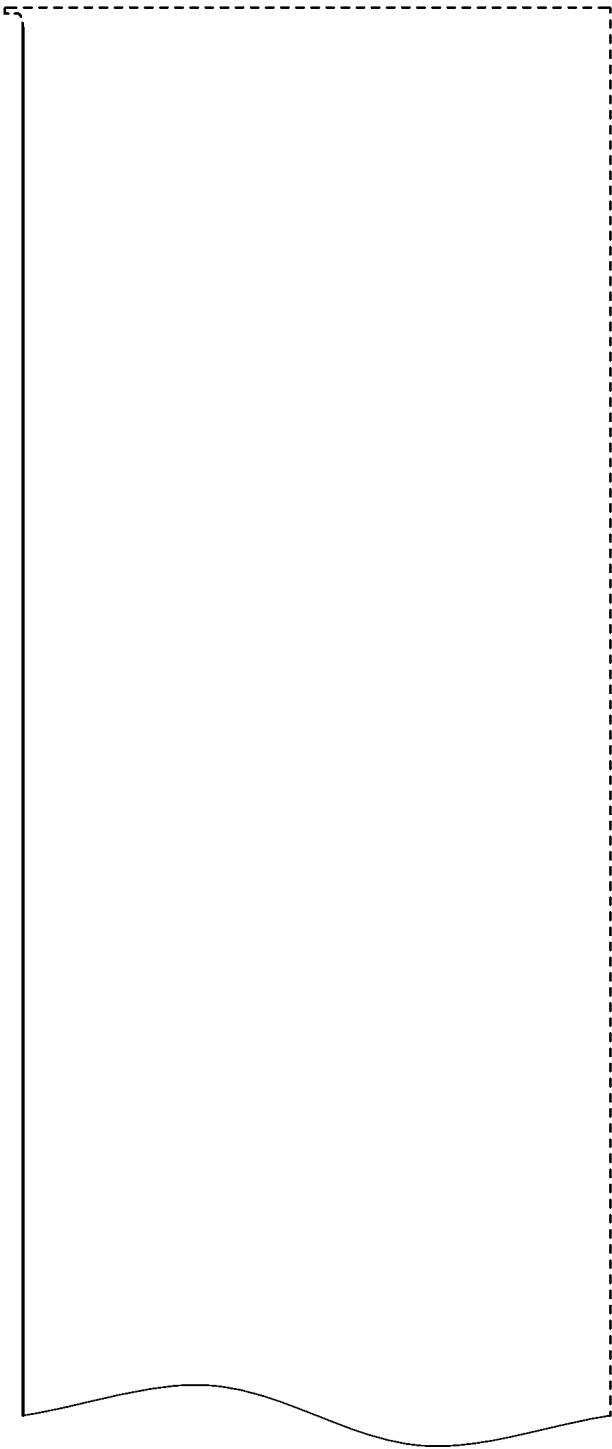
【俯視圖】



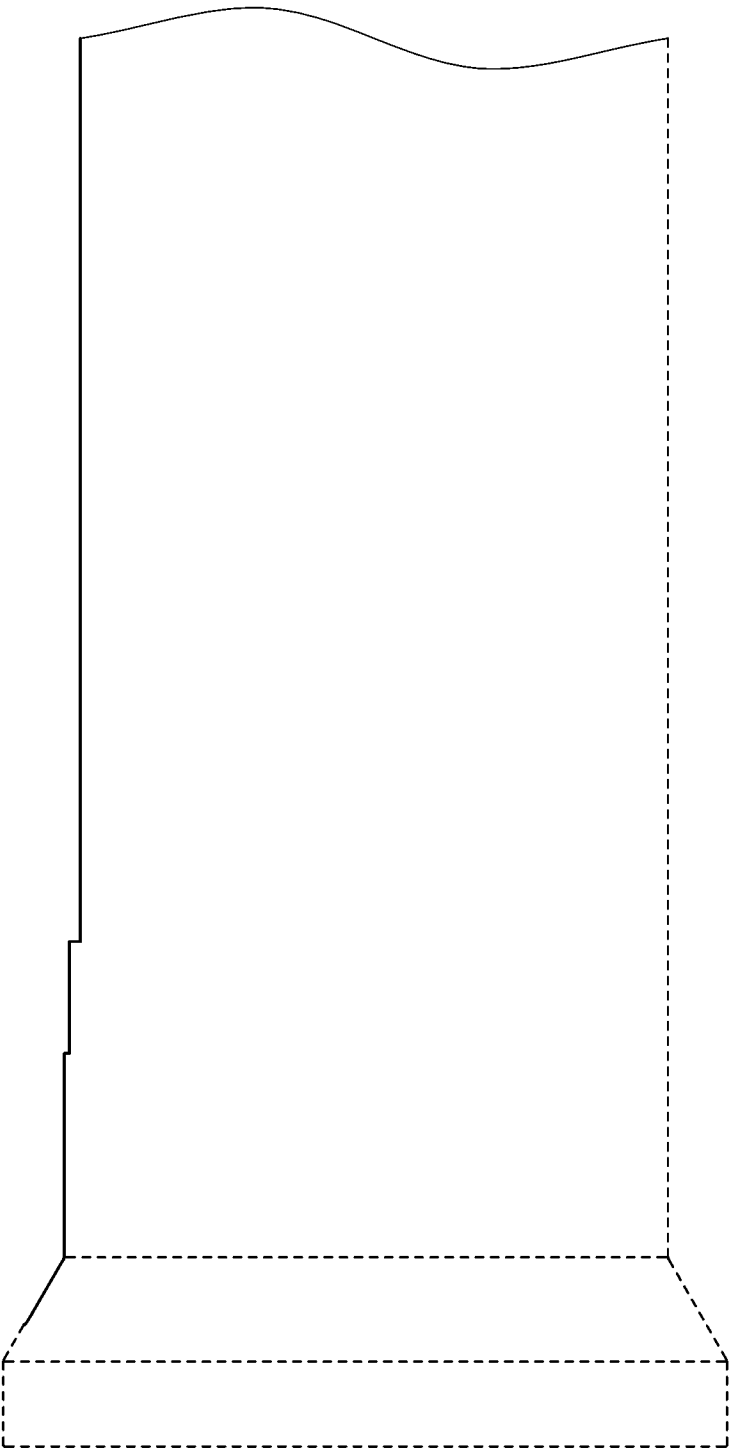
【仰視圖】



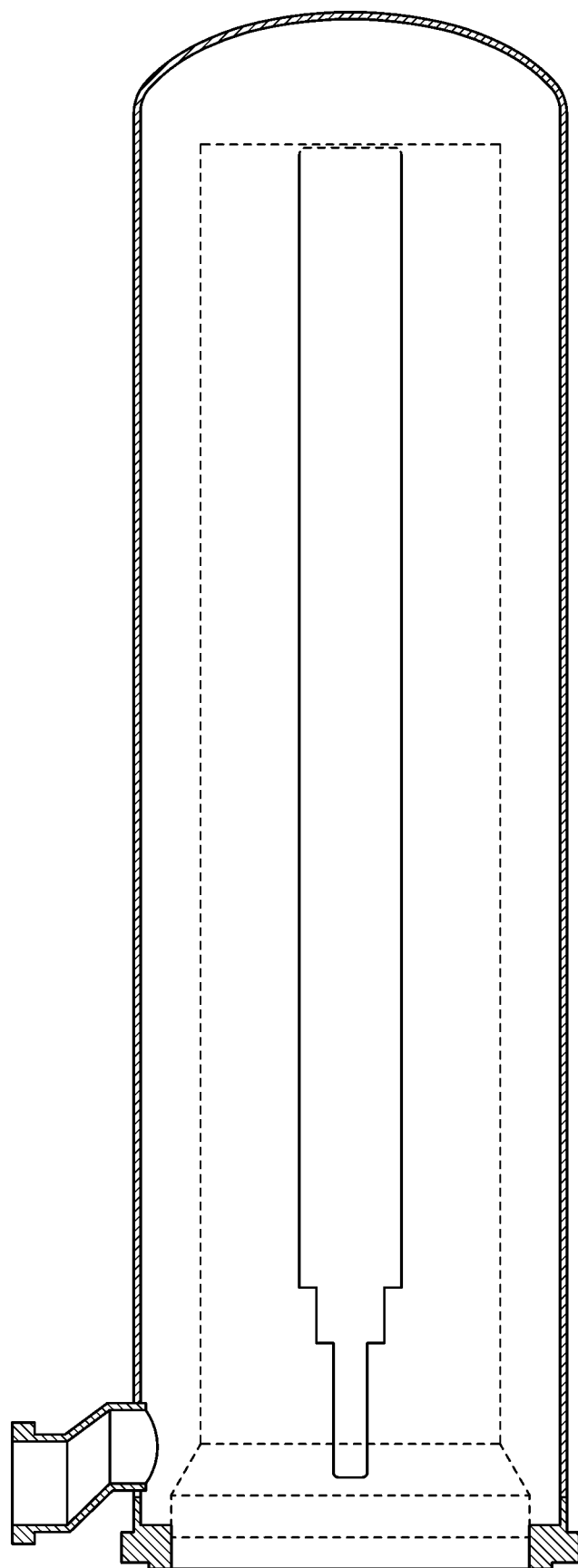
【A-A線剖面圖】



【上半部之A-A線部分放大剖面圖】



【下半部之A-A線部分放大剖面圖】



【顯示使用狀態之參考剖面圖】